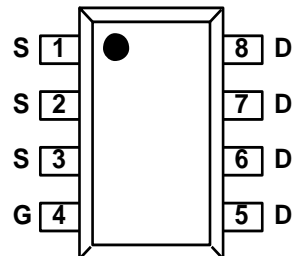




一、特点

- 30V 高密度设计的 P 沟道 MOS 管
- 超低导通电阻
- $R_{DS(ON)} < 53m\Omega @ V_{GS} = -10V$
- $R_{DS(OFF)} < 65m\Omega @ V_{GS} = -4.5V$



二、产品应用

- 笔记本电脑的电源管理、便携式设备和电池供电系统

SOP-8

三、电特性

- 极限参数 ($T_A = 25^\circ C$, 除其它特殊说明)

| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
|-----------|-----------|----------|------------|
| V_{DSS} | 漏源极电压 | -30 | V |
| V_{GSS} | 栅源极电压 | ± 12 | V |
| I_D | 连续漏电流 | -4 | A |
| I_{DM} | 脉冲漏电流 | -15 | A |
| I_S | 二极管连续正向电流 | -1 | A |
| T_J | 最高结温 | 150 | $^\circ C$ |
| T_{STG} | 贮存温度 | -55~150 | $^\circ C$ |

- 静态电特性 ($T_A = 25^\circ C$, 除其它特殊说明)

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------|----------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| BV_{DSS} | 漏源极击穿电压 | $V_{GS} = 0V, I_{DS} = 250\mu A$ | -30 | | | V |
| I_{DSS} | 零栅极电压漏电流 | $V_{DS} = -24V, V_{GS} = 0V$ | | | -1 | μA |
| | | $T_A = 25^\circ C$ | | -30 | 30 | μA |
| $V_{GS(th)}$ | 门阈值电压 | $V_{DS} = V_{GS}, I_{DS} = 250\mu A$ | -0.6 | -0.8 | -1.1 | V |
| I_{GSS} | 栅极漏电流 | $V_{GS} = \pm 12V, V_{DS} = 0V$ | | | ± 100 | nA |
| $R_{DS(ON)}$ | 漏源极导通电阻 | $V_{GS} = -10V, I_{DS} = -0.5A$ | | 43 | 53 | $m\Omega$ |
| | | $V_{GS} = -4.5V, I_{DS} = -0.5A$ | | 50 | 65 | $m\Omega$ |
| | | $V_{GS} = -2.5V, I_{DS} = -0.5A$ | | 60 | 100 | $m\Omega$ |
| V_{SD} | 二极管正向电压 | $I_{SD} = -1A, V_{GS} = 0V$ | | -0.7 | -1.3 | V |